

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**О дополнении постановления Президиума РАН от 16 апреля 2002 г. № 109
(представление Отделения нанотехнологий и информационных технологий)**

Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 2 постановления Президиума РАН от 16 апреля 2002 г. № 109 «О создании Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН» следующими основными направлениями научной деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук:

расчет и моделирование систем на кристалле с интегрированными антеннами и усилителями для крайне высоких частот в диапазоне от 50 до 250 ГГц;

исследование принципов функционирования и разработка СВЧ опто-электронных генераторов в частотном диапазоне от сотен мегагерц до сотен гигагерц;

создание терагерцовых устройств на полупроводниковой электронике в частотном диапазоне от 300 до 900 ГГц.

2. Директору Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук доктору технических наук Мальцеву П.П. представить на утверждение в установленном порядке соответствующие изменения в Устав Института.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН академика Велихова Е.П.

Президент Российской академии наук
академик Ю.С.Осипов

И.о. главного ученого секретаря Президиума Российской академии наук
доктор экономических наук В.В.Иванов